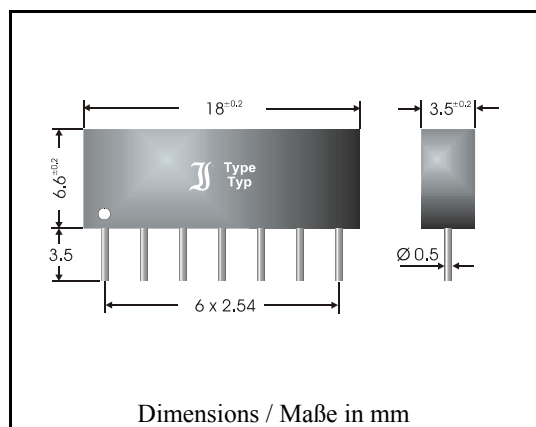
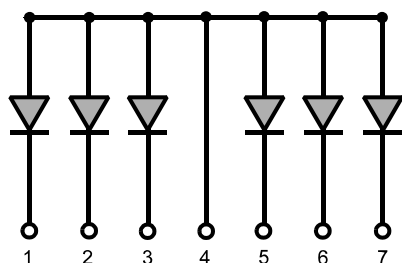
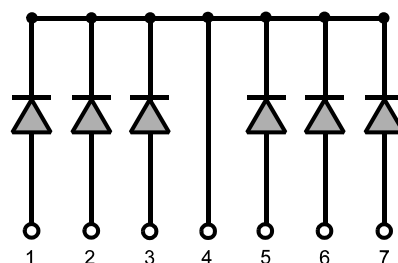


Small Signal Diode Arrays
Dioden Sätze mit Allzweckdioden


| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Nominal power dissipation | 200 mW |
| Nenn-Verlustleistung | |
| Repetitive peak reverse voltage | 80 V |
| Periodische Spitzensperrspannung | |
| 7 Pin-Plastic case | 18 x 3.5 x 6.6 [mm] |
| 7 Pin-Kunststoffgehäuse | |
| Weight approx. – Gewicht ca. | 0.6 g |
| Standard packaging: bulk | see page 22 |
| Standard Lieferform: lose im Karton | s. Seite 22 |



"DAP": common anodes / gemeinsame Anoden



"DAN": common cathodes / gemeinsame Kathoden

Maximum ratings
Grenzwerte

| Type Typ | Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] | Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V] |
|-------------|--|---|
| DAN 601 | 80 | 80 |
| DAP 601 | 80 | 80 |

Max. average forward rectified current, R-load,
for one diode operation only
per diode for simultaneous operation

$T_A = 25^\circ\text{C}$

| | |
|-----------|----------------------|
| I_{FAV} | 100 mA ¹⁾ |
| I_{FAV} | 33 mA ¹⁾ |

Dauergrenzstrom in Einwegschtaltung mit R-Last,
für eine einzelne Diode
pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb

$T_U = 25^\circ\text{C}$

| | |
|-----------|----------------------|
| I_{FAV} | 100 mA ¹⁾ |
| I_{FAV} | 33 mA ¹⁾ |

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwell

$T_A = 25^\circ\text{C}$

| | |
|-----------|--------|
| I_{FSM} | 500 mA |
|-----------|--------|

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur

T_j – 50...+150°C
 T_s – 50...+150°C

Characteristics

Kennwerte

| | | | | |
|---|--|----------------------|-----------|----------------------|
| Forward voltage Durchlaßspannung | $T_j = 25^\circ\text{C}$ | $I_F = 10\text{ mA}$ | V_F | $< 1.0\text{ V}^1)$ |
| Leakage current Sperrstrom | $T_j = 25^\circ\text{C}$ | $V_R = 20\text{ V}$ | I_R | $< 25\text{ nA}$ |
| Reverse recovery time Sperrverzögerung | $I_F = 10\text{ mA}$ through/über $I_R = 10\text{ mA}$ to/auf $I_R = 1\text{ mA}$ | | t_{rr} | $< 4\text{ ns}$ |
| Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft | | | R_{thA} | $< 85\text{ K/W}^2)$ |

¹⁾ Valid per diode – Gültig pro Diode

²⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten